

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-11226

⑬ Int. Cl.⁹

G 02 F 1/136
H 01 L 21/336
29/784

識別記号

5 0 0

庁内整理番号

9018-2K

⑭ 公開 平成4年(1992)1月16日

9056-4M H 01 L 29/78 3 1 1 Y

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

⑮ 発明の名称 表示装置の製造方法

⑯ 特 願 平2-114654

⑰ 出 願 平2(1990)4月27日

⑱ 発 明 者 橋 爪 勉 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

⑲ 出 願 人 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 細 書

1. 発 明 の 名 称

表示装置の製造方法

2. 特 許 請 求 の 範 囲

薄膜トランジスタにより画素電極をオン／オフするようにしたアクティブマトリクス方式の表示方法の製造において、

透明基板上にシリコン膜を形成する工程と、

上記シリコン膜をパターニングする工程と、

上記アモルファスのシリコン膜上にゲート

絶縁膜及びゲート電極を形成する工程と、

上記絶縁膜を介してシリコン膜に不純物を注入する工程と、

シリコン膜にパルスレーザービームを透明基板のシリコン膜が被着形成されていない側の面から照射して加熱することによりシリコン膜を結晶化する工程と、

上記不純物を注入されたシリコン膜に、パルスレーザービームを透明基板のシリコン膜が被着形成されていない側の面から照射して

不純物を活性化させることにより上記薄膜トランジスタのソース領域及びドレイン領域を形成する工程とを有することを特徴とする表示装置の製造方法。

3. 発 明 の 詳 細 な 説 明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、液晶ディスプレイの製造方法、特に例えばアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイの製造に適用して好適な表示装置の製造方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、各画素に形成された薄膜トランジスタにより画素電極をオンオフして表示を行なうアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイが知られている。特開昭61-248080号公報のように第3図A及び第3図Bに示すように、この液晶ディスプレイに於いては、透明なガラス基板301上に、ITO(Indium Tin Oxide)からなる画素電極302、この画素電極302をオンオフするための薄

膜トランジスタT、ゲート・バス・ライン303及びソース・バス・ライン304が形成されている。上記薄膜トランジスタTは、上記ゲートバスライン303と一体的に形成されているゲートでんきよく305、二酸化珪素膜または窒化膜のようなゲート絶縁膜306、真性の(1型)の水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)膜307、n⁺型のa-Si:H膜からなるソース領域308及びドレイン領域309により構成されている。この場合、ソース領域308は上記ソースバスライン304と接続され、ドレイン領域309はアルミニウム(Al)のような金属の配線310により上記画素電極302と接続されている。尚、第3図Aにおいては、上記ゲート絶縁膜306、a-Si:H膜107、ソース電極108及びドレイン電極109の図示は省略されている。

また、特開平1-241862号公報のように、第3図及び第4図に示すようにこのディスプレイでは、透明なガラス基板501上に画素電極形成用のシリコン膜503と、上

記画素電極503をオンオフするための、上記画素電極形成用のシリコン膜と一体化しているシリコン膜で形成された薄膜トランジスタTFT、ゲート・バス・ライン510及びソース・バス・ライン515が形成されている。上記トランジスタTは、上記ゲートバスラインと一体的に形成されているゲート電極、二酸化珪素膜(または窒化膜)のようなゲート絶縁膜507、真性(1型)の水素化アモルファスシリコンにパルスレーザービームを照射して結晶化されたシリコン膜、LIMPID(Laser Induced Melting of Predeposited Impurity Doping)法と呼ばれている不純物ドーピング法で形成されたソース領域及びドレイン領域により構成されている。上記トランジスタは自己整合的にシリコン膜に不純物がドーピングされるので、ソース領域及びドレイン領域はゲート電極に対して自己整合的に形成されている。この場合、ソース領域は上記ソースバスラインと接続され、ドレイン領域と画素電極は得いシリコン膜によって一体形成されている。なお、第5図に於いて

は、上記ゲート絶縁膜、真性(1型)の水素化アモルファスシリコンにパルスレーザービームを照射して結晶化されたシリコン膜、ソース領域及びドレイン領域は省略されている。

(発明が解決しようとする課題及び目的)

上述の第3図の従来のアクティブマトリクス液晶ディスプレイに於ける薄膜トランジスタTはa-Si:H膜307を用いて構成されている。このa-Si:H膜307は、プラズマCVD法を用いることにより耐熱性の無いガラス基板(例えば亜み点が650℃程度の無アルカリガラス)基板301上に形成することができる。しかし、このa-Si:H膜307中のキャリア(電子)の移動度は十分に高いとはいえない。また、この薄膜トランジスタTのソース領域308及びドレイン領域309はゲート電極305に対して自己整合的に形成することができないため、これらのソース領域308及びドレイン領域309とゲート電極305との合わせ精度が悪く、ソース領域308とゲート電極305

との間に寄生容量C_{gs}が、ドレイン領域309とゲート電極との間に寄生容量C_{ds}が発生し、上記薄膜トランジスタの応答速度が遅くなり、また上記薄膜トランジスタが複数個製作された場合には、各々の薄膜トランジスタで発生する寄生容量C_{gs}とC_{ds}の大きさの違いに起因する、トランジスタ特性のばらつきが発生することになる。

また、上述の第4図の従来のアクティブマトリクス液晶ディスプレイの於ける薄膜トランジスタTは、a-Si:H膜をパルスレーザーアニールを施して結晶化されたシリコン膜を用いている。さらに、LIMPIDと呼ばれている不純物導入法を用いて、ソース領域及びドレイン領域をゲート電極に対して自己整合的に形成しているが、この不純物導入の際にもパルスレーザーアニールを施している。しかしこの方法では二度もパルスレーザーアニールを必要とし工程が複雑である。さらに、最初のパルスレーザーアニールで、ソース領域及びドレイン領域までも結晶化し、P膜から不純物のPの拡散能力が低下してい

るため、二度目のパルスレーザーアニールで、効率的にソース領域及びドレイン領域が形成されない欠点がある。さらに、P膜がゲートバスラインとなるアルミニウム層に被着形成されているため、LIMPID法を行なう際に、アルミニウムが加熱されPがアルミニウム膜中に拡散して、ゲートバスラインの抵抗率が変化してしまう欠点がある。

従って本発明の目的は、安価なガラス基板や樹脂基板を用いてキャリアの移動度の高い高性能の薄膜トランジスタを製造することができる表示装置の製造方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、薄膜トランジスタのソース領域及びドレイン領域をゲート電極に対して自己整合的に形成することができる表示装置の製造方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、レーザーアニールを複数回にしないように製造方法を簡略化することのできる表示装置の製造方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、レーザーアニールに

よって、ゲートバスラインの抵抗率を変化させない表示装置の製造方法を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、薄膜トランジスタにより画素電極をオン／オフするようにしたアクティブマトリクス方式の表示方法の製造において、透明基板上にシリコン膜を形成する工程と、上記シリコン膜をパターニングする工程と上記アモルファスのシリコン膜上にゲート絶縁膜及びゲート電極を形成する工程と、上記絶縁膜を介してシリコン膜に不純物を注入する工程と、シリコン膜にパルスレーザービームを透明基板のシリコン膜が被着形成されていない側の面から照射して加熱することによりシリコン膜を結晶化する工程と、上記不純物を注入されたシリコン膜に、パルスレーザービームを透明基板のシリコン膜が被着形成されていない側の面から照射して不純物を活性化させることにより上記薄膜トランジスタのソース領域及びドレイン領域を形成する工程と

を有することを特徴とする表示装置の製造方法である。

〔作用〕

上記した手段によれば、結晶化されたシリコン膜により薄膜トランジスタを形成できるので、キャリアの移動度を高くすることができる。しかも、シリコン膜がアモルファスシリコン膜であれば、アモルファスシリコン膜の形成及びその結晶化、ソース領域及びドレイン領域を形成するための不純物の注入及び活性化などはいずれも室温から300℃程度の低温で行なうことができる。したがって、安価なガラス基板や樹脂基板を用いて高性能の薄膜トランジスタを製造することができる。また、低圧化学堆積法(LPCVD法)で、反応ガスをモノシランまたはジシランまたはポリシランを用い、550℃以下の温度でシリコン膜を形成すれば、室温から300℃の温度で形成されるアモルファスなシリコン膜よりも水素の含有量の少ないシリコン膜が形成できる。したがって、安価なガラス基板(

例えば、コーニング社製7059ガラスの様な無アルカリガラス)を用いて、プラズマCVD法による室温～300℃の温度で形成されるシリコン膜を用いて構成された薄膜トランジスタよりもより高性能な薄膜トランジスタを形成することができる。また、パルスレーザービームの照射により、薄膜トランジスタの活性領域の結晶化と同時に、ゲート電極に対して自己整合的にシリコン膜に不純物の活性化が行なわれるので、薄膜トランジスタのソース領域及びドレイン領域をゲート電極に対して自己整合的に形成することができる。さらに、薄膜トランジスタの活性領域の結晶化と、ソース領域及びドレイン領域の形成を一度のパルスレーザーアニールにより形成されるので、従来のように複数回のパルスレーザーアニールを必要としなくなり、したがって製造工程を簡略化することができる。

また、ソース領域及びドレイン領域を形成するための不純物ドーピングのための不純物層(例えばP膜)の形成及びパルスレーザーアニール後の不純物層の除去する工程を必要

としないので、この分工程が少なくなり、したがって製造工程を簡略化することができる。

さらに、従来のようにゲートバスラインを形成した後に不純物ドーピングをするためのパルスレーザーアニールを、透明基板のゲートバスラインが被着形成されている面側から施す必要が無いために、ゲートバスラインの抵抗率の変化がなくなり、薄膜トランジスタに良好な信号を供給することができる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例について図面を参照しながら説明する。この実施例は本発明をアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイの製造に適用した実施例である。

第1図Aから第1図Fは本発明の一実施例によるアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイの製造方法を工程順に示し、第2図はその完成状態を示す。なお、第1図A～第1図Dは、第2図のZ-Z線に沿っての断面図である。

本実施例に於いては、第1図Aに示すよう

に示すようにゲートバスライン115を形成する。

次に、上記絶縁膜104を透過して上記シリコン層に達するように、第1図Bに示すように例えばリンをイオン注入法によって、例えば 100 KeV の加速電圧で例えば $3 \times 10^{18}\text{ cm}^{-2}$ の密度で不純物をドーピングして、第1図Cに示すようにイオン注入されたシリコン層107を形成する。この時上記ゲート電極の遮蔽効果によって、薄膜トランジスタTの活性化領域には上記不純物はドーピングされない。

次に、例えば室温でパルスエネルギービーム108を、上記透明基板101の、上記シリコン層103が被着形成されている面の反対側の面から、例えば室温でパルスレーザービームを照射する。このパルスレーザービームとしては、XeClエキシマレーザーによるパルスレーザービーム(波長 308 nm)を用いることができ、そのパルス幅は例えば 45 ns 、照射エネルギー密度は例えば $200 \sim 300\text{ mJ/cm}^2$ である。このパルス

に、まずあらかじめ洗浄された透明なガラス基板101に例えばプラズマCVD法により例えば室温 $\sim 300^\circ\text{C}$ 程度の基板温度で例えば膜厚 500 \AA の窒化膜 SiN 102の絶縁膜を形成する。上記窒化膜によってガラス基板101からの汚染を防止することができる。

次に、例えばプラズマCVD法によって全面に上記絶縁膜102を覆うように例えば基板温度が 300°C で、例えば膜厚が 500 \AA 程度のアモルファスなシリコン層を形成する。上記アモルファスなシリコン層をエッチングにより、後述の薄膜トランジスタのソース領域及びドレイン領域及び活性領域となる島状のパターン103を形成する。次に例えばAPCVD法により、上記島状のシリコン層を覆うように基板温度 800°C で二酸化珪素膜による絶縁膜104を 1500 \AA 形成する。次に、例えばスパッタ法により金属膜たとえば 2000 \AA のクロム金属膜を上記絶縁膜104を覆うように被着形成する。上記クロム金属膜をエッチングにより所定の形状にパターニングして、ゲート電極105及び第2図

レーザービーム108の照射により上記a-Si: H膜103が瞬間的に加熱され、イオン注入されたシリコン層中の不純物が活性化され、第1図Eに示すように不純物が活性化されたシリコン層109が形成されると同時に、後述の薄膜トランジスタTの活性化領域となる領域が結晶化され第1図Eに示すように結晶化されたシリコン層110が形成される。このパルスレーザービームの照射により、上記ゲート電極105に対して自己整合的にソース領域及びドレイン領域が形成することができる。これによってソース領域及びドレイン領域に抵抗率は、 $10^{-2} \sim 10^{-3}\Omega \cdot \text{cm}$ と低くすることができる。

つぎに、ゲート絶縁膜の所定部分を除去してソース領域及びドレイン領域に達するようにコンタクトホールを形成したのち、例えばアルミニウムをスパッタ法でゲート絶縁膜に被着形成して、このアルミニウム膜をエッチングして所定の形状にパターニングして、ソース領域に達するソースバスライン114を形成する。つぎに、透明電導膜たとえばIT

O膜をスパッタ法で被着形成して、このITO膜をエッチングして所定の形状にパターンニングして画素電極113を形成する。次に、ゲート電極及びソースライン及び画素電極を覆うように、絶縁膜例えば窒化膜115を被着形成する。当該絶縁膜115は、外部環境からの汚染を防止する。

つぎに、結晶化されたシリコン層110と絶縁膜104との界面の特性改善や、結晶化されたシリコン層が例えば多結晶シリコン膜の場合、当該多結晶シリコン層を構成するシリコンの微結晶の粒界の特性改善のために必要に応じて、例えば水素を含むガスで例えば300℃の温度でアニールを施す。この後、全面に液晶配向膜を形成した後、液晶の封入工程を経て、目的とする液晶ディスプレイが完成する。

本実施例によれば次のような種々な利点がある。すなわち、パルスレーザービーム108の照射により、 α -Si:H膜の結晶化を室温で行うことができる。また、ソース領域112及びドレイン領域112を、イオン注

入及びパルスレーザービーム108の照射によって室温で形成することができる。したがって、耐熱性はないが安価なガラス基板を用いてキャリア（電子）の移動度が高い高性能の薄膜トランジスタTを室温〜300℃の低温プロセスで製造することができる。この薄膜トランジスタTにより、高速でしかもより大きな電流のスイッチングを行うことができる。また、この薄膜トランジスタTの活性領域である結晶化されたシリコン層110と、ソース領域及びドレイン領域の不純物の活性化をわずか一度のパルスレーザーアニールによって形成されるため、記述の従来の液晶ディスプレイに比べて、パルスレーザーアニールの工程が少なくなり、したがってこの分だけ製造工程を簡略する事ができる。

さらに、ゲート電極105に対して自己整合的にシリコン層108に不純物がドーピングされるので、ソース領域111及びドレイン領域112をゲート電極105に対して自己整合的に形成することができる。この結果、薄膜トランジスタTの応答速度が速くなり、

又、ゲート電極とドレイン領域、及びゲート電極とソース領域の間の寄生容量がなくなるため、画質ムラの無い良質な映像を得ることができる。

以上、本発明の実施例に付き具体的に説明したが、本発明は、上述の実施例に限定されるものではなく、本発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

例えば、パルスレーザービーム108としては、例えばXeFエキシマレーザーによるパルスレーザービーム（波長351nm）も用いることが可能である。

また、上述の実施例に於いては、本発明を液晶ディスプレイの製造に適用した場合に付いて説明したが、本発明は、液晶ディスプレイ以外のアクティブマトリクス法式の表示装置の製造に適用することが可能である。例えば、上述の実施例における画素電極113上の層間絶縁膜115を除去し、表示用物質として液晶の代わりに例えばエレクトロクロミック（EC）材料を用いれば、アクティブマトリクス方式のエレクトロクロミックディ

スプレイを製造することができる。なお、液晶の代わりに光りセンサー材料を用いれば、二次元センサーを製造することもできる。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、アモルファスシリコン膜にパルスレーザービームを照射して加熱する事により結晶化するとともに、イオン注入法により、注入された不純物例えばPまたはBの活性化もパルスレーザービームで実施されるので、安価なガラス基板を用いて高性能の薄膜トランジスタを製造することができる。また、ゲート電極に対して自己整合的に不純物が注入され、パルスレーザービームによって活性化されるので、薄膜トランジスタのソース領域及びドレイン領域をゲート電極に対して自己整合的に形成することができる。さらに、薄膜トランジスタの活性領域となるシリコン層の結晶化と、ソース領域及びドレイン領域を形成するための不純物の活性化を、たった一度のパルスレーザービームによって実施できることによっ

て、従来の技術により大幅に工程を簡略化することができる。さらに、ソース領域及びドレイン領域を形成するためにリソグラフィ工程を必要としないため、少なくともこの分だけリソグラフィ工程の数が少なくなり、これによって製造工程を簡略化することができる。

4. 図面の簡単な説明

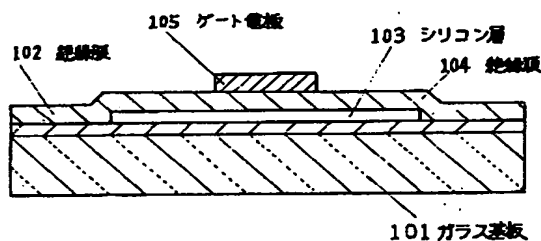
第1図A～第1図Fは本発明の一実施例によるアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイの製造方法を工程順に説明するための断面図、第2図は第1図A～第1図Fに示す方法により製造された液晶ディスプレイの完成状態を示す斜視図、第3図Aは従来のアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイの一例を示す斜視図、第3図Bは第3図AのX-X断面図、第4図Aは従来例である特開平1-241862の発明のアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイの斜視図、第5図(a)～(d)は第4図のアクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイの製造方法を工程順

に説明するY-Y断面図である。

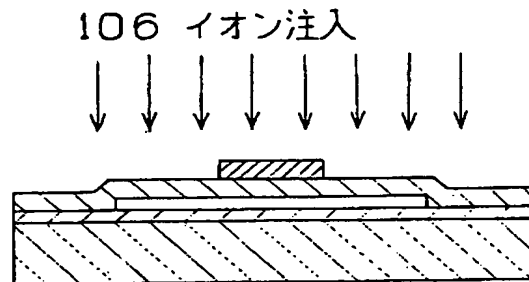
図面における主な符号の説明

101はガラス基板、102は絶縁膜、103はシリコン層、104は絶縁膜、105はゲート電極、106はイオン注入、107はイオン注入されたシリコン層、108はパルスレーザービーム、109は不純物が活性化されたシリコン層、110は結晶化されたシリコン層、111はソース領域、112はドレイン領域、113は画素電極、114はソースバスライン、115は絶縁膜である。

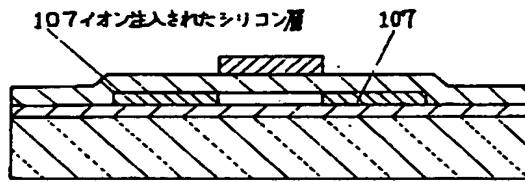
403は画素電極、410はゲート電極、412はソース領域、415はソース・バスライン、501はガラス基板、502は絶縁膜、503はa-Si:H膜、504は絶縁膜、505はパルス・レーザー・ビーム、506は結晶化されたSi膜、507は絶縁膜、508は金属膜、510はゲート電極、511は不純物層、512はソース領域、513はドレイン領域を兼ねた画素電極、514は層間絶縁膜、515はソース・バスラインである。



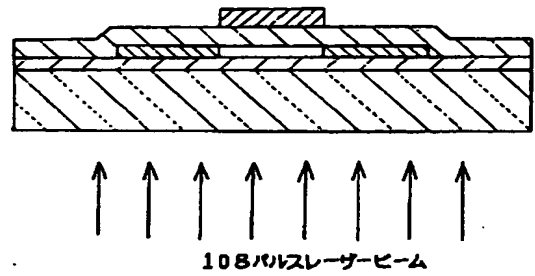
第1図A



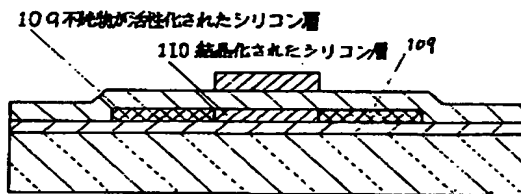
第1図B



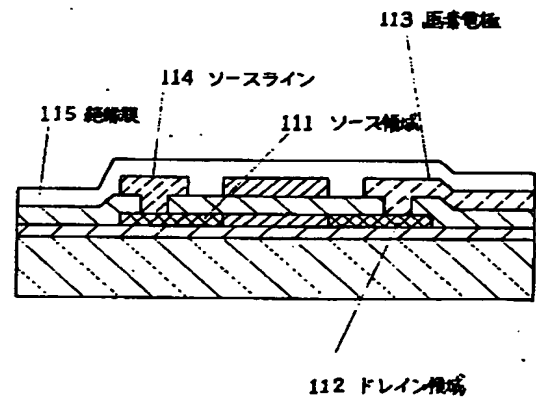
第 1 図 C



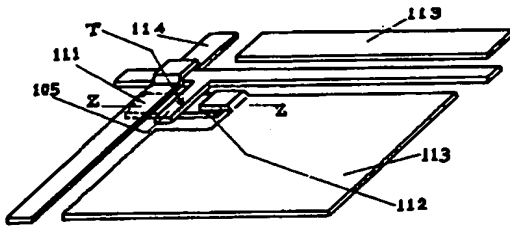
第 1 図 D



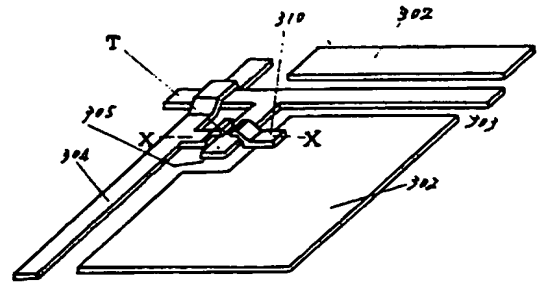
第 1 図 E



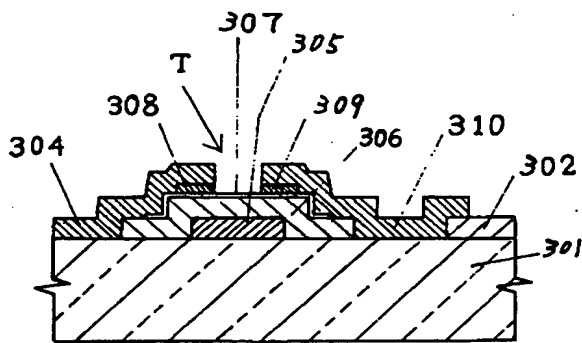
第 1 図 F



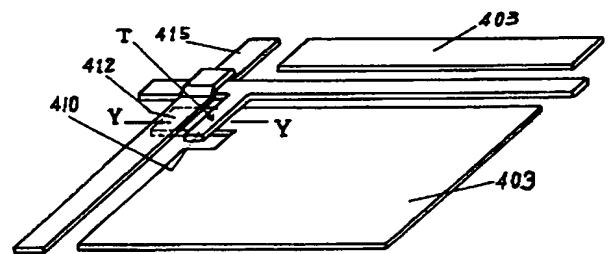
第 2 図



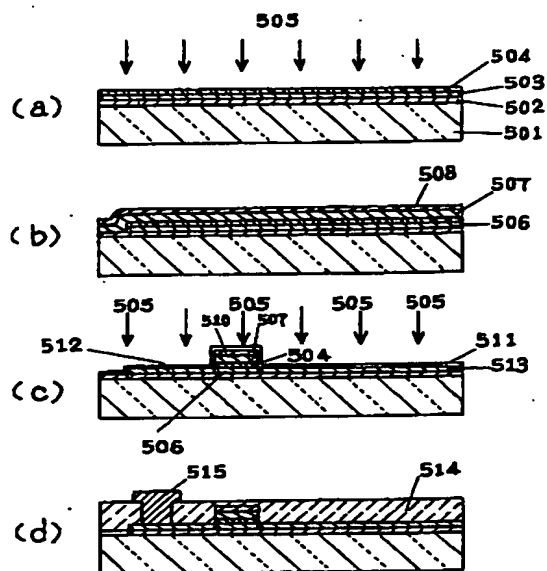
第 3 図 A



第 3 図 B



第 4 図 A



第 5 図